

物理電子システム創造専攻

平成18年度修士論文発表会プログラム ver.5.0(2月7日版)

2月8日(木)会場: G221 講義室

発表時間: 25分 = 発表15分 + 質疑10分

司会は各指導教員

開始	氏名	指導教員(正)	指導教員(副)	論文題目	審査員
9:30	畑山 智裕	徳光 永輔		有機金属化学気相成長法により形成した Al ₂ O ₃ /SiC 構造の界面制御と MOSFET への応用に関する研究	徳光、岩井、大見
9:55	藤村 朋史	徳光 永輔		ITO/強誘電体(BLT)構造薄膜トランジスタの作製と特性向上に関する研究	徳光、石原、筒井
10:20	高野 友一	徳光 永輔		上部絶縁体に HfAlO を用いた金属/絶縁体/強誘電体/絶縁体/半導体構造キャパシタの作製とデバイス応用に関する研究	徳光、石原、有本
10:45	佐藤 雅樹	大見俊一郎		ECR-Ar/N ₂ プラズマによる HfON ゲート絶縁膜の形成とデバイス特性向上に関する研究	大見、岩井、徳光
11:10					
11:20	梅山 将志	石原 宏		強誘電体ゲートトランジスタの低電圧化に関する研究	石原、有本、徳光
11:45	齋藤 貢一	石原 宏		シリケート添加強誘電体を用いた 2T 型メモリセルの作製に関する研究	石原、徳光、大見
12:10	矢野 亜季	石原 宏		強誘電体ゲートトランジスタの作製と評価	石原、有本、徳光
12:35					
13:20	濱島 英孝	筒井 一生		Si 基板上 SrxCd1-xF ₂ 混晶の成長特性とその共鳴トンネルデバイスへの応用	筒井、石原、徳光
13:45	齋藤 格広	筒井 一生		Si 基板上弗化物共鳴トンネルデバイスの縦方向多段集積に関する研究	筒井、石原、渡辺
14:10					
14:20	大井川 誠	伊藤 治彦		光ポンピングを用いたレーザ冷却原子のスピン偏極に関する研究	伊藤、宗片、梶川
14:45	矢橋 健一	大見俊一郎		SBSI 技術による極薄 SOI/BOX 層形成プロセスに関する研究	大見、石原、筒井

物理電子システム創造専攻

平成18年度修士論文発表会プログラム ver.5.0(2月7日版)

2月8日(木)会場：G223 講義室

発表時間：25分 = 発表15分 + 質疑10分

司会は各指導教員

開始		氏名	指導教員 (正)	指導教員 (副)	論文題目	審査員
9:30		石松 祐輔	半那 純一		強誘電性を有する液晶性有機半導体に関する基礎研究	半那、谷、宗片、梶川
9:55		川島 学	半那 純一		相分離を利用した低分子液晶性有機半導体とポリマー複合系の形成と評価	半那、谷、宗片、梶川
10:20		尾崎 浩児	梶川浩太郎		ポリジアセチレンナノ微粒子の3次非線形光学効果	梶川、青柳、宗片
10:45		長山 哲哉	梶川浩太郎		ドライプロセスによる金ナノ微粒子の作製	梶川、青柳、半那
11:10						
11:20		渡辺 恒介	青柳 克信		非線形光学材料を用いたフォトニック結晶の作製と光機能素子への応用	青柳、宗片、梶川
11:45		清水 博史	青柳 克信		深紫外発光素子用高品質 AlGaIn 形成に関する研究	青柳、筒井、梶川
12:10		藤森 文浩	青柳 克信		短チャネル有機 TFT 実現のための研究	青柳、半那、梶川
12:35		信谷 和隆	宗片比呂夫		強磁性半導体(Ga,Mn)As の高品質化に関する研究	宗片、半那、菅原
13:00		小林 紘子	宗片比呂夫		強磁性半導体 ZnCrTe の磁気起源の研究	宗片、半那、菅原
13:25						
14:10	進学	鈴木 左文	浅田 雅洋		共鳴トンネルダイオード THz 発振器の高出力化に向けた発振素子アレイに関する研究	浅田、小山、植之原、渡辺、宮本
14:35		花島 君俊	浅田 雅洋		オフセット給電スロットアンテナによる共鳴トンネルダイオード THz 発振素子の研究	浅田、小林、渡辺
15:00		宮地 正人	浅田 雅洋		InP ショットキーバリアダイオードを用いた THz 帯検出器に関する研究	浅田、小山、渡辺
15:25						
15:35		内田 薫	渡辺 正裕		弗化物系サブバンド間遷移レーザーの SOI 構造プラズモン導波路の作製	渡辺、浅田、植之原
16:00		小平 新志	渡辺 正裕		Si 基板上 CdF ₂ /CaF ₂ 活性層を用いたサブバンド間遷移レーザーの精密結晶成長に関する研究	渡辺、浅田、宮本
16:25		藤井 諒	渡辺 正裕		Si(100)基板上 CdF ₂ /CaF ₂ 共鳴トンネルダイオードの高品質結晶成長に関する研究	渡辺、浅田、筒井

物理電子システム創造専攻

平成18年度修士論文発表会プログラム ver.5.0(2月7日版)

2月9日(金)

会場: G221

発表時間: 25分 = 発表15分 + 質疑10分

司会は各指導教員

開始		氏名	指導教員 (正)	指導教員 (副)	論文題目	審査員
9:30		山内 拓弥	益 一哉		動的再構成可能広帯域 CMOS 無線回路の研究	益、岩井、筒井
9:55		清田 淳紀	益 一哉		オンチップ伝送線路を用いた高速信号伝送回路の研究	益、石原、大見
10:20		木村 実人	益 一哉		差動伝送線路を用いた高速信号伝送技術に関する研究	益、小林、徳光
10:45						
10:55		川添 大輔	益 一哉		動的再構成可能 CMOSRF 低雑音増幅器に関する研究	益、石原、岩井
11:20		上園 巧	益 一哉		統計的性能評価を用いた集積回路の製造容易化設計に関する研究	益、中山、前島
11:45		伊藤 雄作	益 一哉		動的再構成可能広帯域 CMOS RF 発振器に関する研究	益、石原、杉野
12:10						
13:15	進学	小林 勇介	筒井 一生		マルチゲート・トランジスタの形状に依存する寄生効果低減と特性ゆらぎ解析	筒井、岩井、石原、益、大見
13:40	進学	舘 喜一	岩井 洋		A Study on Process Optimization for High Performance La2O3-MOS Devices	岩井、石原、大見、有本、中山
14:05		塩澤 崇史	岩井 洋		Improvement of Thermal Stability of Ni Silicide on Heavily Doped N-type Si	岩井、筒井、中山
14:30		椎野 泰洋	岩井 洋		Novel Rare Earth Oxides Gate Stack for Advanced La2O3 MOSFET	岩井、石原、大見
14:55						
15:05		中川 昌幸	岩井 洋		Study on RF Characteristics and Modeling of Scaled MOSFET	岩井、益、有本
15:30		永廣 侯治	岩井 洋		Thermal Stability of NiSi improved by Post Silicidation Metal Doping Method	岩井、筒井、徳光
15:55	進学	宋 在烈	岩井 洋		A Study on Process Optimization of Ge-MOS Devices with La2O3 Gate Dielectric	岩井、益、筒井、徳光、杉井

物理電子システム創造専攻

平成18年度修士論文発表会プログラム ver.5.0(2月7日版)

2月9日(金)

会場：G223

発表時間：25分=発表15分+質疑10分

司会は各指導教員

開始	氏名	指導教員(正)	指導教員(副)	論文題目	審査員
9:30	金澤 慈	小山二三夫		高歪 GaInAs/GaAs 量子井戸レーザの高温動作に関する研究	小山、小林、宮本
9:55	北林 直人	小山二三夫		面発光レーザアレイの多波長集積化と合波技術に関する研究	小山、植之原、宮本
10:20	平野 豪	小山二三夫		面型光変調器の帯域制御に関する研究	小山、植之原、納富
10:45					
10:55	岩崎 鷹博	宮本 智之		トンネル注入レーザの分子ビーム成長と発振特性に関する研究	宮本、小山、植之原
11:20	柏原 吉浩	宮本 智之		GaAs 系長波長面発光レーザの光学特性・温度特性同時制御に関する研究	宮本、小林、小山
11:45	佐々木洋輔	納富 雅也	小山二三夫	負屈折率フォトニック結晶による光伝搬特性の制御に関する研究	納富、小山、植之原
12:10					
13:15	城岸 直輝	小林 功郎		金属埋め込み微小メサ構造を用いた InGaAs/GaAs 系面発光レーザの高速直接変調特性に関する研究	小林、小山、宮本
13:40	田中 紳公	小林 功郎		透過型面型変調器の動作特性に関する研究	小林、小山、植之原
14:05	盛田 琢也	小林 功郎		SOA-MZI の超高速 1×2 全光スイッチング動作に関する研究	小林、小山、植之原
14:30					
14:40	岡本 健資	植之原裕行		光ラベルスイッチ用時間分離型多波長ラベル生成技術に関する研究	植之原、小林、小山
15:05	高梨 雄介	植之原裕行		半導体光増幅器の相互位相変調特性を用いたタイミング制御型光信号再生器に関する研究	植之原、小林、宮本